

★電子ディスプレイ研究会 (EID)

専門委員長 木村 睦 副委員長 志賀智一・小南裕子

幹事 伊達宗和・山口雅浩 幹事補佐 山口留美子・野中亮助・新田博幸・小尻尚志・中田 充

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 12月12日(金) 10:00~18:00

会場 京都大学工学研究科桂キャンパス(京都市西京区京都大学桂 A1, 阪急京都線:桂駅からバス15分, <http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/downloademap> TEL [075] 383-2300 木本恒暢)

議題 シリコン関連材料の作製と評価, 及びディスプレイ技術

1. 長方形断面 Ge ナノワイヤの正孔移動度の断面形状及びサイズ依存性
○田中 一・森 誠悟・森岡直也・須田 淳・木本恒暢(京大)
 2. p チャネル Si ナノワイヤ MOSFET の移動度の結晶方位及び断面形状依存性
○藤原寛朗・森岡直也・田中 一・須田 淳・木本恒暢(京大)
 3. B+ 及び B10H14+ 注入 Si 基板の軟 X 線照射による活性化
○部家 彰・平野翔大・草壁 史・松尾直人・神田一浩(兵庫県立大)
 4. DNA メモリトランジスタの電荷保持機構と伝導機構
○中村昇平・松尾直人・山名一成・部家 彰・高田忠雄(兵庫県立大)・福山正隆・横山 新(広島大)
 5. 炭素系多原子分子イオンのシリコンへの照射効果
○竹内光明・林 恭平・龍頭啓充・高岡義寛(京大)・永山 勉・松田耕自(日新イオン機器)
 6. エレクトロルミネッセンス(EL)発光強度を用いたシリコン太陽電池モジュールの光電変換機能解析
○富本剛史・都築翔太・谷 あゆみ・冬木 隆(奈良先端大)
 7. ボロン含有シリコンナノインクを用いたレーザードーピングによる高効率シリコン太陽電池への応用
○真鍋満顕・阪川秀紀・西村英紀(奈良先端大)・富澤由香・池田吉紀(帝人)・冬木 隆(奈良先端大)
 8. 電界効果型マイクロウォール太陽電池 ○大木康平・若宮彰太・小林孝裕・部家 彰・松尾直人(兵庫県立大)
- 午後
9. n-ch, p-ch, pin-ch poly-Si TFT の光伝導性の評価
○測矢剛宏・木村 睦・松田時宜・前田善春・門目堯之・田中 匠(龍谷大)
 10. N 型・P 型・PIN 型薄膜フォトトランジスタを用いた周波数変調型フォトセンサの特性比較
○前田善春・門目堯之・田中 匠・測矢剛宏・春木翔太・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 11. スパッタリングにより形成した HfO₂ 膜をゲート絶縁膜とする CLC 低温 Poly-Si TFT
○目黒達也・原 明人(東北学院大)
 12. Poly-Si TFT を用いたハイブリッド型温度センサの特性比較
○木藤克哉・林 久志・北島秀平・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 13. Poly-Si TFT を用いた同期回路と非同期回路の特性評価
○永瀬洋介(龍谷大)・小林 光・松本健俊(阪大)・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 14. レーザーアニールによる非晶質基板上への(111)面配向多結晶ゲルマニウム薄膜の形成
○高尾 透・堀田昌宏・石河泰明・浦岡行治(奈良先端大)
 15. ゲート付き Poly-Si Hall 素子と IGZO Hall 素子による磁場センサの研究開発
○松本貴明・吉川朗登・宮村祥吾・志賀春紀・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 16. GaSnO 薄膜の特性評価 ○加藤雄太・西本大樹・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 17. IGZO 薄膜に対する成膜条件による影響 ○西野克弥・高橋宏太・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 18. ITZO TFT を用いたタッチパネル回路の特性解析 ○古我祐貴・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 19. 空孔率制御によるポーラスシリコン膜の自己組織的3次元微細構造形成
○石黒敬太・出野上真樹・青木画奈・藤井 稔(神戸大)
 20. 軟 X 線源を用いた SiO_x 中 nc-Si の形成
○草壁 史・平野翔大・部家 彰・松尾直人・神田一浩・望月孝晏・宮本修治(兵庫県立大)・小濱和之・伊藤和博(阪大)
 21. Si 面 4H-SiC n-MOSFET における Split C-V 特性の周波数依存性
○結城広登(奈良先端大)・矢野裕司(奈良先端大/筑波大)・冬木 隆(奈良先端大)
 22. シングルパルス Id-V_{gs} 測定による 4H-SiC MOSFET の界面特性評価
○磯野弘典(奈良先端大)・矢野裕司(奈良先端大/筑波大)・冬木 隆(奈良先端大)

23. 4H-SiC BJT の電流増幅率の温度依存性 ○浅田聡志・奥田貴史・木本恒暢・須田 淳 (京大)
24. 水蒸気を用いたプラズマ誘起原子層堆積法による Al_2O_3 膜の形成
○梅原智明・堀田昌宏・吉嗣晃治・石河泰明・浦岡行治 (奈良先端大)
25. 二元系遷移金属酸化物メモリにおける抵抗変化ドライビングフォースの検討
○小石遼介・森山拓洋・木村康平・河野公紀・宮下英俊・李 相錫・岸田 悟・木下健太郎 (鳥取大)
26. NiO を用いた ReRAM のセミフォーミング後における抵抗スイッチング特性
○篠倉弘樹・西 佑介・岩田達哉・木本恒暢 (京大)
27. 抵抗変化メモリ (ReRAM) における導電性パス生成機構の検討—第一原理計算手法を用いた NiO の様々な面方位の表面状態解析— ○森山拓洋 (鳥取大)・山崎隆浩・大野隆央 (物材機構)・岸田 悟・木下健太郎 (鳥取大)

☆EID 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

1月22日(木), 23日(金) 龍谷大〔締切済〕 テーマ: 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会

☆SDM 研究会

【問合せ先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail : kuroda@fff.niche.tohoku.ac.jp